

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
DD5	Микрохема АТ24С256-10РU-2,7	1	имп., маркировка "В" на корпусе
SA	Тумблер R13-66	1	имп.
AI	Субблок БУФП УИИД.426419.077	1	
B1	Резонатор кварцевый FTX11,059M20U	1	имп.
B2	Резонатор кварцевый FTX32,768K12,5D8	1	имп.

УИИД.426419.121 ПЭЗ
Блок БУФП
Перечень элементов

Имя Листов N страниц Листов Дата
Лист 1 из 17
Имя Листов N страниц Листов Дата
Лист 1 из 17

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
C1	Конденсатор керамический многослойный 0805B104K500N (0805 X7R 50 В 0,1 мкФ ±10%)	1	имп., чип
C2	Конденсатор керамический C11 S8 Y5V 3 E 3322 (3мВ-3300пФ +80-20 % 50 В)	1	имп.
C3	Конденсатор электролитический алюминиевый ECR221M50B (10 x 13 мм) (220 мкФ ±20 % 50 В)	1	имп.
C4...C8	Конденсатор керамический многослойный 0805B104K500N (0805 X7R 50 В 0,1 мкФ ±10%)	5	имп., чип
C9	Конденсатор электролитический алюминиевый ECR102M25B (10 x 21 мм) (1000 мкФ ±20 % 25 В)	1	имп.
C10	Конденсатор электролитический алюминиевый ECR470M16B (5 x 11 мм) (47 мкФ ±20 % 16 В)	1	имп.

УИИД.426419.121 ПЭЗ

Имя Листов N страниц Листов Дата
Лист 2 из 2

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
C11	Конденсатор электролитический алюминиевый ECR4R7M50B (5 x 11 мм) (4,7 мкФ ±20 % 50 В)	1	имп.
C12, C13	Конденсатор керамический многослойный 0805N200J500N (0805 NPO/COG 50 В 20 пФ ±5 %)	2	имп., чип
C14	Конденсатор керамический многослойный 0805B104K500N (0805 X7R 50 В 0,1 мкФ ±10 %)	1	имп., чип
C15	Конденсатор керамический многослойный 0805N200J500N (0805 NPO/COG 50 В 20 пФ ±5 %)	1	имп., чип
C16	Конденсатор керамический многослойный 0805B104K500N (0805 X7R 50 В 0,1 мкФ ±10 %)	1	имп., чип
C17	Конденсатор электролитический алюминиевый ECR100M63B (5 x 11 мм) (10 мкФ ±20 % 63 В)	1	имп.

УИИД.426419.121 ПЭЗ

Имя Листов N страниц Листов Дата
Лист 3 из 3

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
C18, C19, C21...C27	Конденсатор керамический многослойный 0805B104K500N (0805 X7R 50 В 0,1 мкФ ±10 %)	9	имп., чип
C28	Конденсатор керамический R20M105M1H45 (1 мкФ ±20 % 50В)	1	имп.
C29	Конденсатор керамический многослойный 0805B104K500N (0805 X7R 50 В 0,1 мкФ ±10%)	1	имп., чип
C30	Конденсатор электролитический алюминиевый ECR100M63B (5 x 11 мм) (10 мкФ ±20 % 63 В)	1	имп.
C31	Конденсатор керамический многослойный 0805B104K500N (0805 X7R 50 В 0,1 мкФ ±10%)	1	имп., чип

УИИД.426419.121 ПЭЗ

Имя Листов N страниц Листов Дата
Лист 4 из 4

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
DD1	MC74HC04ADG	1	имп., корпус SOIC-14
DD2	L7805CV	1	имп., корпус TO-220 PBF-на упаковке
DD3	MC74HC04ADG	1	имп., корпус SOIC-14
DD4	P80C32UFPN	1	имп., корпус DIP-40
DD8	MC74HC02ADG	1	имп., корпус SOIC-14
DD9	MC74HC373ADG	1	имп., корпус SOIC-20
DD11	W24655C-70LL	1	имп., корпус SOIC-28RF
DD12, DD13	MC74HC373ADG	2	имп., корпус SOIC-20
DD14	ULN2003AD	1	имп., корпус SOIC-16 P, 04-на упаковке

УИИД.426419.121 ПЭЗ

Имя Листов N страниц Листов Дата
Лист 5 из 5

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
F1	ВТМ-11-0,25А	1	
F2	ВТМ-5-3,15А	1	
F3	Предохранитель самовосстанавливающийся MF-SM050	1	имп., чип
HA	Звоник пьезокерамический ЗТ-25 12MQ.081.085TV	1	
L1	Дроссель ДМ-0,4-125мГн ±5% ЦКЕН.671.342.001TV	1	
PT	Таймер PCF8583P	1	имп., DIP-8

УИИД.426419.121 ПЭЗ

Имя Листов N страниц Листов Дата
Лист 6 из 6

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
R1	1206S4J0390T (1206-39 Ом ±5% (390))	1	имп.
R2	0805S8J0152T (0805-1,5 кОм ±5% (152))	1	имп.
R3	0805S8J0153T (0805-1,5 кОм ±5% (153))	1	имп.
R4	0805S8J0103T (0805-10 кОм ±5% (103))	1	имп.
R5	1206S4J0102T (0805-1 кОм ±5% (102))	1	имп.
R6	0805S8J0392T (0805-3,9 кОм ±5% (392))	1	имп.
R7	0805S8J0102T (0805-1 кОм ±5% (102))	1	имп.
R8	0805S8J0104T (0805-100 кОм ±5% (104))	1	имп.

УИИД.426419.121 ПЭЗ

Имя Листов N страниц Листов Дата
Лист 7 из 7

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
R9	0805S8J0513T (0805-5,1 кОм ±5% (513))	1	имп.
R10	0805S8J0103T (0805-10 кОм ±5% (103))	1	имп.
R11, R12	0805S8J0512T (0805-5,1 кОм ±5% (512))	2	имп.
R13...R20	0805S8J0103T (0805-10 кОм ±5% (103))	8	имп.
R21	Резистор подстроечный CA9 STD H 2,5 10к 20% A	1	имп.
R22	0805S8J0512T (0805-5,1 кОм ±5% (512))	1	имп.
R23	0805S8J0152T (0805-1,5 кОм ±5% (152))	1	имп.
R25	0805S8J0392T (0805-3,9 кОм ±5% (392))	1	имп.
R26, R27	0805S8J0103T (0805-10 кОм ±5% (103))	2	имп.

УИИД.426419.121 ПЭЗ

Имя Листов N страниц Листов Дата
Лист 8 из 8

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
R29	0805S8J0392T (0805-3,9 кОм ±5% (392))	1	имп.
R30, R31	0805S8J0103T (0805-10 кОм ±5% (103))	2	имп.
R32	0805S8J0512T (0805-5,1 кОм ±5% (512))	1	имп.
R33	1206S4J0390T (0805-39 Ом ±5% (390))	1	имп.
R34	0805S8J0752T (0805-7,5 кОм ±5% (752))	1	имп.
R35	0805S8J0103T (0805-10 кОм ±5% (103))	1	имп.
R36	0805S8J0392T (0805-3,9 кОм ±5% (392))	1	имп.
R37	0805S8J0103T (0805-10 кОм ±5% (103))	1	имп.
R39	Резистор С2-23-0,5-4,7 Ом ±10% А-Д-В ОКQ.467.081TV	1	

УИИД.426419.121 ПЭЗ

Имя Листов N страниц Листов Дата
Лист 9 из 9

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
R40	0805S8J0392T (0805-3,9 кОм ±5% (392))	1	имп.
R41	0805S8J0103T (0805-10 кОм ±5% (103))	1	имп.
R42	0805S8J0513T (0805-5,1 кОм ±5% (513))	1	имп.
R43	0805S8J0104T (0805-100 кОм ±5% (104))	1	имп.
R44	0805S8J0103T (0805-10 кОм ±5% (103))	1	имп.
R45...R48	0805S8J0102T (0805-1 кОм ±5% (102))	4	имп.
R49	0805S8J0513T (0805-5,1 кОм ±5% (513))	1	имп.
R50, R51	0805S8J0103T (0805-10 кОм ±5% (103))	2	имп.
R52	0805S8J0102T (0805-1 кОм ±5% (102))	1	имп.

УИИД.426419.121 ПЭЗ

Имя Листов N страниц Листов Дата
Лист 10 из 10

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
R53	0805S8J0512T (0805-5,1 кОм ±5% (512))	1	имп.
R54	0805S8J0103T (0805-10 кОм ±5% (103))	1	имп.
RU1	Варистор дисковый оксидно-цинковый MYG 14K220	1	имп.
T1	Трансформатор ТП-216-1 КУВШ.671111.037TV	1	
VD1	Стабилитрон BZX55C7V5	1	имп., RoHS Compliant
VD2...VD4	Диод импульсный универсальный LL4148	3	имп., чип, корпус SOD-80 GREEN PRODUCT
VD5	Стабилитрон BZV55C3V9	1	имп., чип, корпус SOD-80 P на упаковке
VD8	Стабилитрон TZMB16	1	имп., чип, корпус SOD-80 P на упаковке

УИИД.426419.121 ПЭЗ

Имя Листов N страниц Листов Дата
Лист 11 из 11

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
VD9	Диод 1N4007	1	имп., Lead Free Plating
VD10	Индикатор мнемонический L-424HDТ	1	имп., P на упаковке
VD11	Диод импульсный универсальный LL4148	1	имп., чип, корпус SOD-80 GREEN PRODUCT
VD12...VD16	Диод 1N4007	5	имп., Lead Free Plating
VD17...VD21	Диод импульсный универсальный LL4148	6	имп., чип, корпус SOD-80 GREEN PRODUCT
VD23	Диод SA18	1	имп.
VD24	Диод 1N19	1	имп., P на упаковке
VD25	Диод 11DQ04	1	имп., P на упаковке

УИИД.426419.121 ПЭЗ

Имя Листов N страниц Листов Дата
Лист 12 из 12

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
VT1	ТРИ22	1	имп., корпус TO-92 P на упаковке
VT2, VT3	BC 847B	2	имп., чип, корпус SOT23, P на упаковке
VT4, VT5, VT7, VT8	BC 807-16	4	имп., чип, корпус SOT23, P на упаковке, маркировка SA
VT9...VT11	BC 847B	3	имп., чип, корпус SOT23, P на упаковке

УИИД.426419.121 ПЭЗ

Имя Листов N страниц Листов Дата
Лист 13 из 13

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
XP1	Штыри на плату PLS-3	1	имп.
XP2, XP3	Штыри на плату PLS-2	2	имп.
XS1...XS3	Джампер MJ-0 (6мм)	3	имп.
XS4	840-AG100-ES	1	имп., (DD4)
XS5	808-AG100-ES	1	имп., (DD5)
XS6	828-AG100-ES	1	имп., (DD10)

УИИД.426419.121 ПЭЗ

Имя Листов N страниц Листов Дата
Лист 14 из 14

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
AI	Субблок БУФП УИИД.426419.077-06	1	
DD6	Микрохема АТ24С64-10РU-2,7	1	имп.
DD10	Микрохема W27C512-45Z	1	имп., V3.0, версия модели 01
AI	Субблок БУФП УИИД.426419.077-07	1	
DD6	Микрохема АТ24С64-10РU-2,7	1	имп.
DD10	Микрохема W27C512-45Z	1	имп., V3.0, версия модели 01

УИИД.426419.121 ПЭЗ

Имя Листов N страниц Листов Дата
Лист 15 из 15

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
A3	Субблок БУФП УИИД.426419.077-08	1	
C20	Конденсатор керамический многослойный 0805B104K500N (0805 X7R 50 В 0,1 мкФ ±10%)	1	чип, имп.
DD7	Микрохема АТ24С256-10РU-2,7	1	имп.
DD10	Микрохема W27C512-45Z	1	имп., V3.0, версия модели 02
R24	0805S8J0103T (0805-10 кОм ±5% (103))	1	имп.
R28	0805S8J0512T (0805-5,1 кОм ±5% (512))	1	имп.
R38	1206S4J0560T (1206-56 Ом ±5% (560))	1	имп.
VT6	Транзистор BC847B	1	чип, имп.

УИИД.426419.121 ПЭЗ

Имя Листов N страниц Листов Дата
Лист 16 из 16